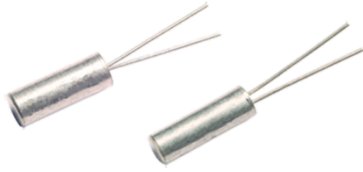


DT-26 DT-38



产品特点及应用范围:



- KHz 级频率范围
- 频率精度高
- 体积小
- 无铅环保产品
- 通讯设备
- 嵌入式设备
- 物联网

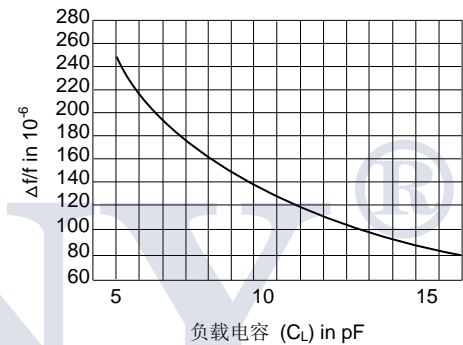
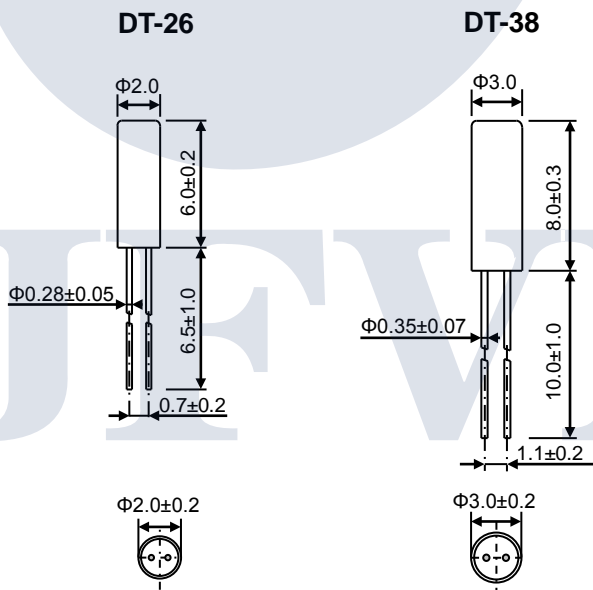


产品性能

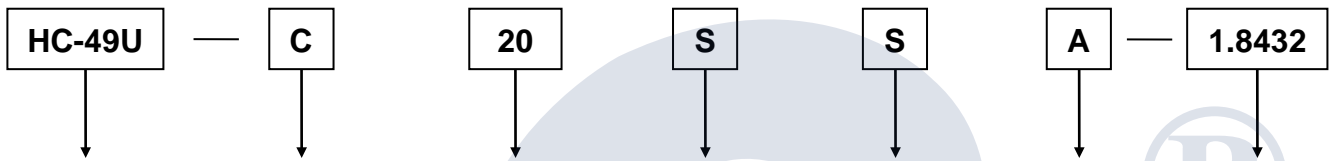
性能参数		DT-26	DT-38
频率范围 (KHz)	F ₀	32.768~200.00	
振动模式	Mode	基频	
串联谐振电阻 (Ω)	R _r	60KΩ Max.	50KΩ Max.
频率精度 (25°C 时)	F _{tol}	±5×10 ⁻⁶ , ±10×10 ⁻⁶ ±15×10 ⁻⁶ , ±20×10 ⁻⁶	
Q 值	Q Factor	70,000 Typ. 40,000 Min.	80,000 Typ. 50,000 Min.
温度系数	B	-0.04×10 ⁻⁶ /°C ²	
储存温度范围	T _{stg}	-55°C~+125°C	
静电容	C ₀	1.1pF Typ.	1.3pF Typ.
负载电容	CL	6.0pF、12.5pF	
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V	
激励功率	DL	1 μW Max.	
老化率	F _{age}	±3×10 ⁻⁶ /年 Max.	

外形尺寸 (mm)

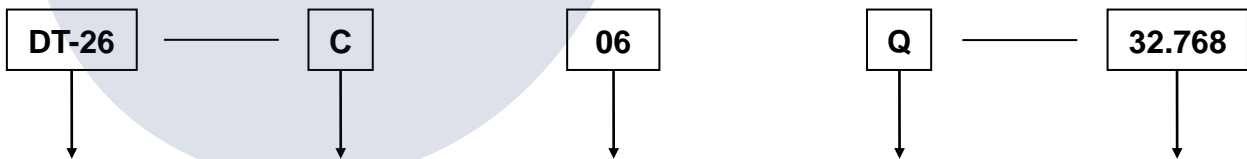
负载电容特性



晶体谐振器选型指南



封装	工作温度范围	负载电容	频率精度 (25°C)	频率温度稳定度	振动模式	标称频率 (MHz)	
HC-33U	A=0°C~+50°C	00=串联	N=±5×10 ⁻⁶	N=±5×10 ⁻⁶	A=AT-基频	请直接写出标称频率的值	
HC-49U	B=-10°C~+60°C	06=6.0pF	O=±10×10 ⁻⁶	O=±10×10 ⁻⁶	B=BT-基频		
HC-49UX	C=-20°C~+70°C	08=8.0pF	P=±15×10 ⁻⁶	P=±15×10 ⁻⁶	D=DT切		
HC-49H	G=-40°C~+85°C	09=9.0pF	Q=±20×10 ⁻⁶	Q=±20×10 ⁻⁶	N=NT切		
HC-49S	Q=-40°C~+125°C	10=10pF	S=±30×10 ⁻⁶	S=±30×10 ⁻⁶	X=X切		
HC-49SU	H=-55°C~+85°C	12=12pF	T=±50×10 ⁻⁶	T=±50×10 ⁻⁶	TA=AT-3 RD		
HC-49SN	J=-55°C~+125°C	16=16pF		U=±100×10 ⁻⁶	FA=AT-5 TH		
HC-49SA		18=18pF			SA=AT-7 TH		
HC-49SB		20=20pF					
HC-49XA		30=30pF					
HC-49XB	常规温度是“C”	以上是常规负载电容值。	常规精度是“S”,如有特殊	温度稳定度的选择要根据对	振动模式可以根据对应		根据对应说明页的可选频率范围选择。
X16F	如有特殊要求可以根据温度范围和温度稳定度选择。	注意: 根据实际应用电路, 算出负载电容的值。(如何计算, 见说明)	要求可以选择精度高的。	应说明页, 带“●”为可以做到的。	说明页选择。		
X21F							
X25F							
X32F							
X53F							
X53T							
X63F							
X75F							
UM-1							
UM-5							



封装	工作温度范围	负载电容	频率精度 (25°C)	标称频率 (KHz)
DT-26	A=0°C~+50°C	06=6.0pF	N=±5×10 ⁻⁶	请直接写出标称频率的值
DT-38	B=-10°C~+60°C	12=12.5pF	O=±10×10 ⁻⁶	
FC12	C=-20°C~+70°C	根据实际电路算出加给晶体的负载电容值	P=±15×10 ⁻⁶	根据对应说明页的可选频率范围选择。
FC135	G=-40°C~+85°C		Q=±20×10 ⁻⁶	
SSP-T7	常规温度是“C”		常规精度是“Q”, 如有特殊	
MC306	如有特殊要求可以根据温度范围和温度稳定度		要求可以选择精度高的。	